



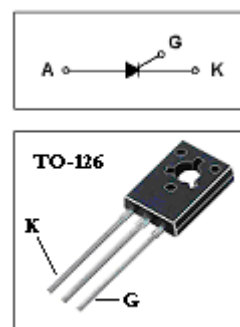
主要用途

单向可控硅，用于过压保护、马达控制、限流电路、加热控制。

极限值 ($T_j=25$)

T_{stg} —— 贮存温度	-40~150
T_j —— 结温	-40~125
V_{DRM} —— 重复峰值断态电压	600V
I_T (RMS) —— RMS 通态电流 (均方值)	6A
$I_{T(AV)}$ —— 平均通态电流 (半正弦波, $T_c=111$)	3.8A
I_{TSM} —— 浪涌通态电流(1/2 周期,60Hz, 正弦波,不重复)	66A
V_{RGM} —— 反向峰值门极电压	5V
I_{FGM} —— 正向峰值门极电流	2.0A
P_{GM} —— 峰值门极功耗.....	5.0W

外形图及引脚排列



电参数 ($T_c=25$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{DRM}	重复峰值断态电流			10 200	μA μA	$V_{AK}=V_{DRM}$ $T_c=25$ $T_c=125$
V_{TM}	峰值通态电压(1)			1.6	V	$I_{TM}=9A$, $t_p=380\mu s$
I_{GT}	门极触发电流(2)			15	mA	$V_{AK}=6V$ (DC), $R_L=10\ ohm$ $T_c=25$
V_{GT}	门极触发电压(2)			1.5	V	$V_{AK}=6V$ (DC), $R_L=10\ ohm$ $T_c=25$
V_{GD}	门极不触发电压(1)	0.2			V	$V_{AK}=12V$, $R_L=100\ ohm$ $T_c=125$
I_H	维持电流			20	mA	$I_T=100mA$, 栅极开路 $T_c=25$
$(dv/dt)_c$	最低电压上升率	200			V/ μs	线性倾斜上升至 $V_D=V_{DRM}$ 67%, 栅极开路, $T_j=125$
$R_{th(j-c)}$	热阻			3.12	/W	结到外壳
$R_{th(j-a)}$	热阻			89	/W	结到环境



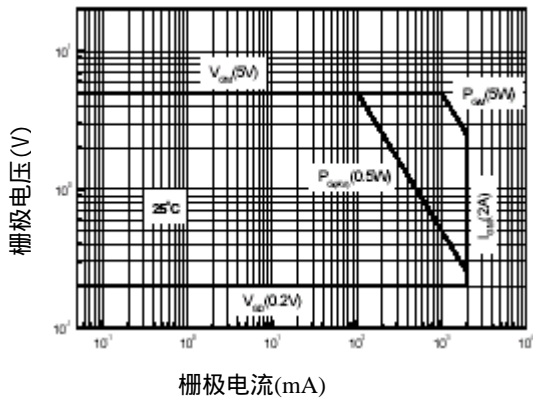
汕头华汕电子器件有限公司

Silicon Controlled Rectifier
HCN6C60

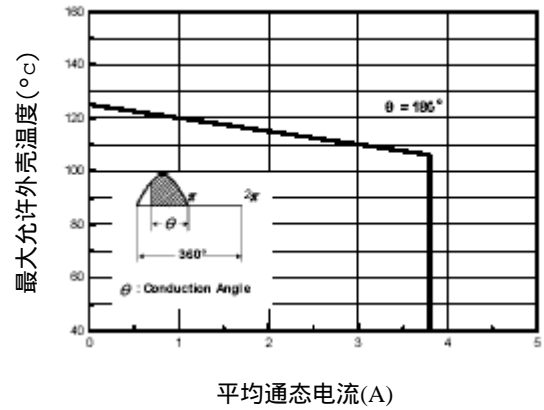
对应国外型号
SCR6C60

特性曲线

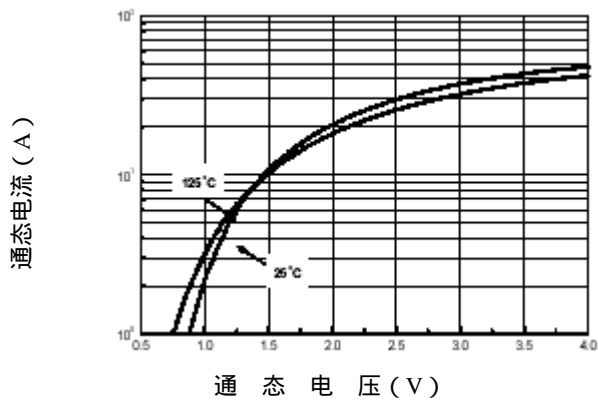
图一、栅极特性



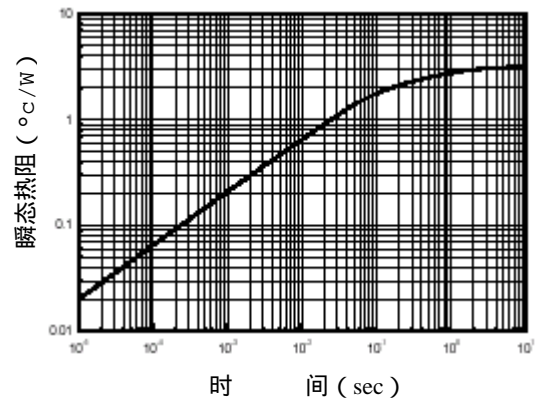
图二、最大外壳温度



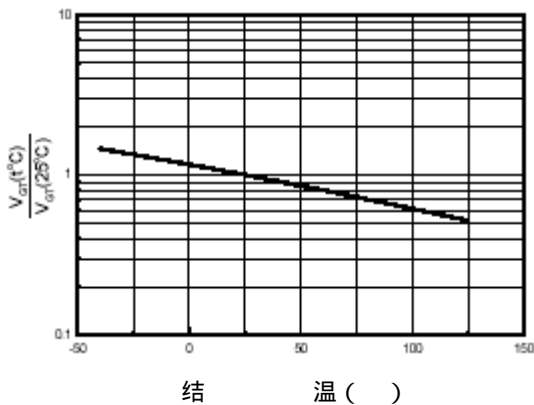
图三、典型正向压降



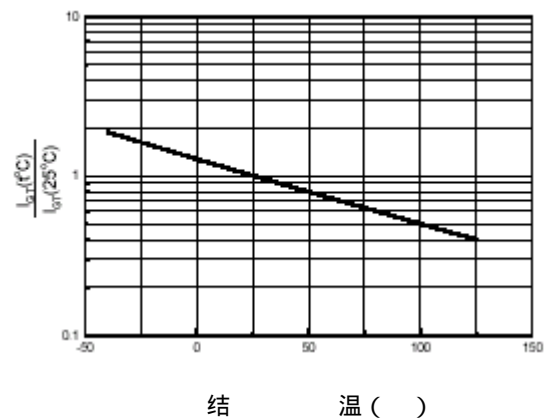
图四、热 响 应



图五、典型栅极触发电压----结温



图六、典型栅极触发电流----结温





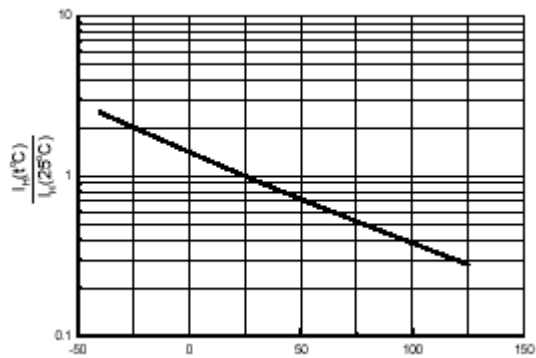
汕头华汕电子器件有限公司

Silicon Controlled Rectifier
HCN6C60

对应国外型号
SCR6C60

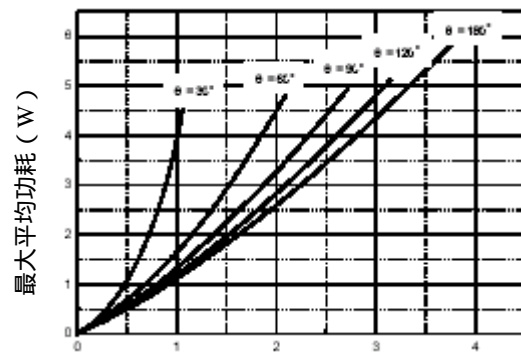
特性曲线

图七、典型维持电流



结 温 ()

图八、功 耗



平均通态电流(A)

注：

- 1、 脉冲宽度等于 1.0ms, 占空因数小于等于 1%
- 2、 测量时不包括 R_{GK} 电流